

研究論文一覧

1. 角 辰巳、森脇 信行、中根 譲治、中熊 哲治、十代 勇治、上本 康裕、長野 能久、林 慎一郎、吾妻 正道、藤井 英治、勝 新一、大槻 達男、Larry McMillan、Carlos Paz de Araujo、加納 剛太、「A 256kb Nonvolatile Ferroelectric Memory at 3V and 100ns」、Proceedings of IEEE International Solid-State Circuits Conference - ISSCC '94 p. 268-269、1994年2月発表、DOI: 10.1109/ISSCC.1994.344646
2. 吾妻 正道、
「Material Optimization of Bismuth Based Mixed Layered Super Lattice Ferroelectric for High Performance FeRAMs」、International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM) Extended Abstract of the SSDM p. 803-805、1996年8月発表、DOI: 10.7567/SSDM.1996.Sympo.II-6
3. 嶋田 恭博、中尾 圭策、井上 敦雄、吾妻 正道、上本 康裕、藤井 英治、大槻 達男
「Temperature effects on charge retention characteristics of integrated $\text{SrBi}_2(\text{Ta},\text{Nb})_2\text{O}_9$ Capacitors」、Applied Physics Letters vol. 71 No. 17 p. 2538-2540、1997年11月発表、DOI: 10.1063/1.120110
4. 藤井 英治、大槻 達男、十代 勇治、嶋田 恭博、吾妻 正道、上本 康裕、長野 能久、那須 徹、井筒 康文、松田 明浩、中尾 圭策、田中 圭介、平野 博茂、伊東 豊二、三河 巧、久都内 知恵、L. D. McMillan、C. A. Paz de Araujo、
「Highly-Reliable Ferroelectric Memory Technology with Bismuth-Layer Structured Thin Films(Y-1 Family)」、International Electron Devices Meeting (IEDM) IEDM Technical Digests p. 597-600、1997年12月発表、DOI: 10.1109/IEDM.1997.650455
5. 藤井 英治、十代 勇治、伊東 豊二、久都内 知恵、長野 能久、野間 淳史、那須 徹、井筒 康文、三河 巧、安岡 創、吾妻 正道、嶋田 恭博、佐々井 洋一、佐藤 和夫、大槻 達男、
「A Highly Reliable Ferroelectric Memory Technology with $\text{SrBi}_2\text{Ta}_2\text{O}_9$ -Based Material and Metal Covering Cell Structure」、IEEE Transactions on Electron Devices vol. 48 issue 6 p. 1231-1236、2001年6月発表、DOI: 10.1109/16.925253
6. 長野 能久、三河 巧、久都内 知恵、林 慎一郎、那須 徹、夏目 進也、立成 利貴、伊東 豊二、後藤 覚、矢野 尚、野間 淳史、永橋 克己、三木 隆、坂上 雅彦、井筒 康文、中村 邦彦、平野 博茂、岩成 俊一、村久木 康夫、山岡 邦吏、五寶 靖、十代 勇治、佐藤 和夫、
「0.18 μm SBT-Based Embedded FeRAM Operating at a Low Voltage of 1.1V」、2003 Symposium on VLSI Technology Digest of Technical Papers p. 171-172、2003年6月発表、DOI: 10.1109/VLSIT.2003.1221140
7. 藤井 英治、内山 潔、
「0.18 μm SBT-Based Embedded FeRAM Operating with Hydrogen Damage Free Stacked Cell Structure」(International Symposium on Integrated Ferroelectrics ISIF 2004 Award for Lifetime Achievement、2004年4月受賞)、Integrated Ferroelectrics vol.53 p. 317-323、2003年6月発表、DOI: 10.1080/10584580390258246

8. 野間 淳史、三河 巧、長野 能久、十代 勇治、藤井 英治、「Two-Mode Behavior in Time and Temperature Dependence of Imprint-Induced Charge Loss in Integrated $\text{SrBi}_2(\text{Ta,Nb})_2\text{O}_9$ Capacitors」、International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM) Extended Abstract of the SSDM p. 44-45、2003年9月発表、DOI: 10.7567/SSDM.2003.B-2-4
9. 長野 能久、三河 巧、久都内 知恵、夏目 進也、立成 利貴、伊東 豊二、野間 淳史、那須 徹、林 慎一郎、平野 博茂、五寶 靖、十代 勇治、藤井 英治、「Embedded Ferroelectric Memory Technology with Completely Encapsulated Hydrogen Barrier Structure」、IEEE Transactions on semiconductor manufacturing vol.18 No.1 p. 49-54、2005年2月発表、DOI: 10.1109/TSM.2004.841821
10. 長野 能久、藤井 英治、「System LSI Embedded Ferroelectric Memory Technology」、2007 Sixteenth IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics (ISAF) p. 11-13、2007年5月発表、DOI: 10.1109/ISAF.2007.4393152